

# Silicon Diode

## **BAQ33**

30V / 200mA

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

## BAQ 33...BAQ 35

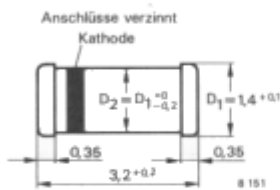
### Silizium-Planar-Dioden

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzögerungsschaltungen

Besondere Merkmale:

- Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm



Glasgehäuse  
SOD 80  
Mini MELF  
Gewicht max. 0,1 g

### Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	<b>BAQ 33</b>	$U_R$	30	V
	<b>BAQ 34</b>	$U_R$	60	V
	<b>BAQ 35</b>	$U_R$	125	V
Stoßdurchlaßstrom				
$t_p = 1 \mu s$		$I_{FSM}$	2	A
Durchlaßstrom		$I_F$	200	mA
Sperrschichttemperatur		$T_j$	200	°C
Lagerungstemperaturbereich		$T_{stg}$	- 65...+ 200	°C

### Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschichttemperatur auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm		$R_{thJA}$	500	K/W
---	--	------------	-----	-----

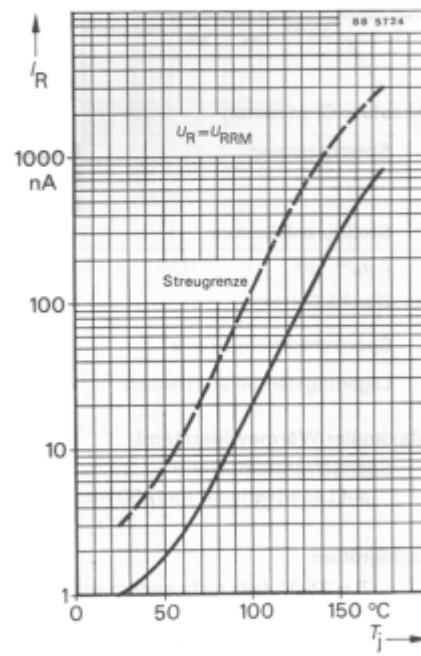
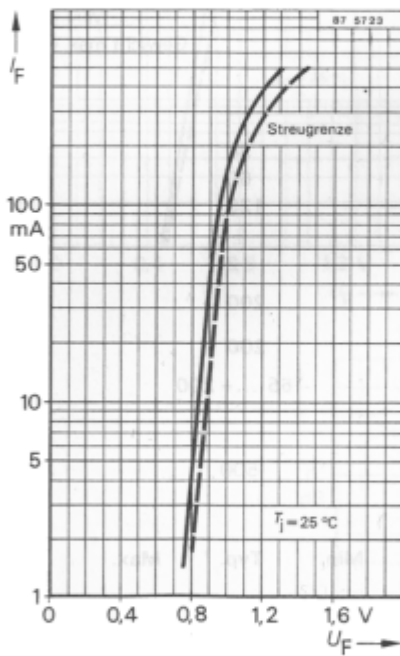
### Kenngößen

$T_j = 25 \text{ °C}$ , falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung					
$I_F = 100 \text{ mA}$				1	V
Sperrstrom					
$E^{11} \leq 500 \text{ lx}$ , $U_R$					
$U_R, T_j = 125 \text{ °C}$			1	3	nA
$U_R = 15 \text{ V}$	<b>BAQ 33</b>			0.5	$I_R$
$U_R = 30 \text{ V}$	<b>BAQ 34</b>			0.5	$I_R$
$U_R = 60 \text{ V}$	<b>BAQ 35</b>			0.5	$I_R$

## BAQ 33...BAQ 35

			Min.	Typ.	Max.	
Durchbruchspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$	<b>BAQ 33</b>	$U_{(BR)}^{1)}$	40			V
	<b>BAQ 34</b>	$U_{(BR)}^{1)}$	70			V
	<b>BAQ 35</b>	$U_{(BR)}^{1)}$	140			V
Diodenkapazität $V_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$		$C_D$			3	pF



<sup>1)</sup>  $\frac{t_p}{T} = 0.01, t_p = 0.3 \text{ ms}$